

关键指标

通带频率: 30.5~32.5GHz
 插入损耗: 1.7dB
 阻带衰减: 30dB@22.6GHz, 30.7dB@36GHz
 回波损耗: 15dB/15dB
 芯片尺寸: 1.5mm×1mm×0.1mm

产品简介

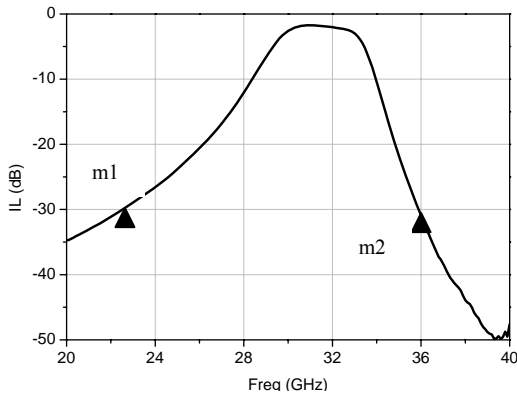
HG118L 是一款带通滤波器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 通带频率为 30.5~32.5GHz, 带内插入损耗小于 1.7dB, 带内输入输出回波损耗为 15dB/15dB。

电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	30.5~32.5		
输入回波损耗(dB)	-	15	-
输出回波损耗(dB)	-	15	-
插入损耗(dB)	-	-	1.7
阻带衰减 @22.6GHz(dB)	-	30	-
阻带衰减 @36GHz(dB)	-	30.7	-

典型测试曲线

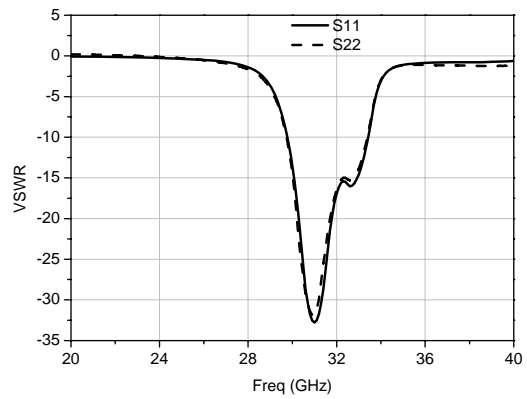
插入损耗



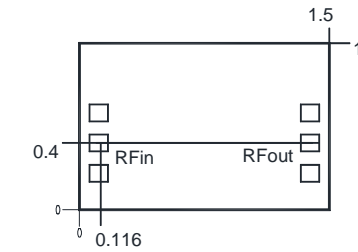
m1
Freq=22.6GHz
dB(S(2,1)) = -30

m2
Freq=36GHz
dB(S(2,1)) = -30.7

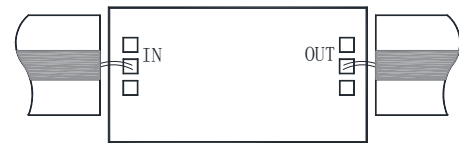
回波损耗



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 μm ;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。